Proceedings of the 18th Linear Accelerator Meeting in Japan, Tsukuba, 21-23 July 1993

FELI ELECTRON LINAC AND IR \sim UV-FEL FACILITIES

T. Tomimasu, Y. Morii, A. Koga, Y. Miyauchi, T. Keishi, E. Nishimura,

K. Saeki, S. Abe, S. Sato, A. Kobayashi, I. Bessho and A. Nagai

Free Electron Laser Research Institute, Inc. (FELI)

2-7-4 Kyomachibori, Nishi-ku, Osaka 550

ABSTRACT

FELI is aiming at IR-FEL generation by the end of 1994 using a 75-MeV beam and a 3-m long undulator and UV-FEL generation by the end of 1996 using a 165-MeV beam and a 3-m long undulator. The linac is composed of a 5-MeV electron injector and seven ETL type accelerating waveguides with a length of 2.93 m($2 \pi / 3$ mode, linearly tapered type). The injector consists of a 150-kV DC thermoionic triode gun operated by a 178.5-MHz, 500-ps pulser, a 714-MHz prebuncher (SHB), and a 2856-MHz standing wave type buncher (SWB). The linac will be operated in three modes of 24 μ s, 12.5 μ s and 0.5 μ s. With a choice of three modes, the maximum accelerated energy can be changed from 165 MeV to 310 MeV.

The linac beam will be sent to four undulators using S-type BT systems installed at 30-MeV, 75-MeV, 120-MeV, and 165-MeV sections at $24-\mu$ s rf pulse operation. The ratio of the cavity length to the undulator length is designed to be less than 3. The beam, once used for lasing at 30-MeV section or at 75-MeV section, can be bent back to the following accelerating waveguide and is reacclerated and reused for lasing.

FEL研電子リニアックと赤外-紫外域FEL施設

1. はじめに

紫外域FEL発生に適した電子加速器として電子リニ アックと電子蓄積リングがあるが、それぞれに欠点があ り、それらを克服する提案がなされてきた。電子リニア ックの場合では、電子ビームのエミッタンス ε とエネル ギー幅が大きく、短波長になるほどFEL波長 λ_R との 関係 $\varepsilon < \lambda_R/\sqrt{2\pi} を満たすのが難しくなる。したがっ$ て、いかにして電子銃で低エミッタンスの大電流・長パルスビームを発生させ、プリバンチャー、バンチャー、 $加速管と密度変調と加速をしながら、エミッタンス <math>\varepsilon$ と エネルギー幅($\Delta E/E$)を大きくしないで電子ビームのバ ンチ化と高エネルギー化を達成するかである。 電子蓄積リングの場合では、もともと電子ビームの ε と△E/Eは小さいので、これらをあまり大きくしない で、いかにして大電流を長寿命で蓄積できるかにかかっ ている[1]。ここでは、これらのことを考慮して設計し たFEL研の5MeV電子入射器を含む電子リニアックと FEL施設について述べる。

2. 5MeV電子入射器

図1に5MeV電子入射器の平面図を示す。電子銃には、 24µsの長パルスビーム発生が可能ということで熱陰極 三極管型(EIMAC Y646B)を用いる。

電子銃は、大気中で使用できるようにDC120kV印加



-21 -

でKentech Instruments社製のパルス幅500ps以下、パルス 電圧140V以上の178.5MHzグリッドパルサーで駆動され る。CLIOやFELIXのデータから1パルス当り 1.2nC、ビームエミッタンス5 π mm・mradのビーム出力 を期待している[2,3]。電子銃アセンブリーは、ICF253で 装着できるようにし、できるだけ軽量化をはかる。

714MHzプリバンチャーは、リエントラント型のサブ ハーモニックバンチャー(SHB)で、電子銃からのサブナ ノ秒パルス電流によって誘起されるrf場の影響を小さ くするためステンレス製である。714MHzのrf周波数 は以下の理由から選んだ。1)できるだけrf空胴を小さ くするため、電極フランジをICF253で、空胴長を20cm 程度にする。2)電子銃からの極短パルス(<500ps)ビーム 長は714MHzの130°以下に相当し、速度変調もうまくや れる。3)マイクロパルスビームと2856MHz/2°の周波数 で発生する在来のマイクロパルスレーザと同期できる。

バンチャーは定在波型のバンチャー(SWB)で、9空胴 である。ピーク電界は2MWrf入力に対して約10MV/m になる。小rf電力で高ピーク電界が得られるのが定在 波型バンチャーの利点であるが、ディスク口径が10mm ゆ近くで、進行波型のディスク口径20mmと比べて小さ いので電子ビームの集束と位置調整に注意が必要である。 そのためSHB-SWB間のドリフトスペースには蛍光板型 とボタンモニター型の位置モニターをそれぞれ2カ所に 設置できるようにした。また、電子ビームの空胴電荷効 果によるエミッタンス増加をできるだけ小さくするため に、電子銃カソードからSWBの第1空胴までの距離を 80cm以下にするように工夫した。図1の電子銃とSHB の間のCM-GVは、パルス電子社製のCMと岸川バルブ 社製のGVを一つにして全長106mmにしたのも工夫の一 つである。

電子銃カソードからSHB第1空胴までの約80cmの間、 カソードから引き出された電子ビームは、まずウエネル ト-アノード間の電界で集束される。図1に示したFC1 ~FC5は集束コイルで、FC1はカソードでの磁界を零に するためのもので、FC2,FC3,FC4で電子ビームは3mm ø以下に絞れるようにKapchinsky-Vladimirsky方程式[4] からそれぞれのアンペアーターンを決めた。図2にビー ム軸に沿った磁界分布を示した。電子ビームのエネルギ ーが5MeV以下の場合にビーム半径rを一定に保つ磁界Bs はK-V方程式から次式で与えられる。

Bs= $2\sqrt{2} \text{ m} \circ c/(e\sqrt{1a}) \cdot \sqrt{1/\beta \gamma}/r$

Bs(T)=3.69x10⁻³√I(A)/β γ/r(m) (1) ここで、m₀は電子の静止質量、cは光速、Iaはアルフィ ン電流(~17000A)、Iはビームのピーク電流、B=v/c、 γ はローレンツ因子である。最大磁界はSWBの近くで 0.19Tになる。表1に電子入射器の主なパラメータを示 した。



図2 磁界分布

表1 電子入射器の主なパラメータ

Gun	Туре	Thermoionic triode
	Energy	≦150 keV
	Micropulse	0.4~0.5 ns
	Microcharge	1.2 nC
	Normalized emittance	<10 π mm mrad
	Macropulse	≦24 <i>µ</i> s
	Repetition frequency	1~10 Hz
Prebuncher	Туре	Re-entrant cavity
	Frequency	714 MHz
	Q-Value	~2000
	Peak field	~50 kV
Buncher	Туре	Standing wave
	Length	~49 cm
	Energy	~5 MeV for 2-MW rf
	Energy spread (FWHM) <130 keV	

3. 電子リニアックのレギュラー部とFEL施設

電子リニアックのレギュラー部は、7本の電総研型加速管(2π/3モード、ディスクロ径定勾配変化型、2.93m長)[5]から構成される。各加速管前後にはステアリングコイル、四重極電磁石、蛍光板型とコアモニター型のビーム検出器、スパッタイオンポンプが配列される。電子リニアックの全長はアンジュレータへのBT系も含めて46mである。バンチャーと7本の加速管には2本のE3729型クライストロン(2856MHz、全rfパワー48MW、24μsパルス長)からrfパワーが供給される。図3には、SHB用1AV88R型クライストロンと2本のE3729型クラ

-22 -

イストロンを含むrf系、電子銃から加速管先端までの 電子リニアックの配列、4台のアンジュレータとBT系 の配列の概略を示した。

ここで使用されるクライストロンは東芝製クライスト ロンE3712の改良型で、通常4µs-80MW、50ppsで使用 されているものを24µsの長パルス運転用として改良し テスト中のものである。電子リニアックは、図3にも示 したように、1) 24µsモード、2) 12.5µsモード、3) 0.5 µsモードの各モードで運転可能である。1)の24µsモー ドは可視-紫外域FEL発生用、2)の12.5µsモードは赤 外域FEL発生や陽電子発生用、3)の0.5µsモードは将 来の電子蓄積リングへの入射や陽電子発生用である。三 つのモードを選択することにより電子リニアックの最大 加速エネルギーは165MeVから310 MeVまで変えられる。 E3729型クライストロンのモジュレータ電源は、440V MG、DC化電源、4並列のPFN回路、30段からなる光サ イリスタースイッチ、1:15パルストランスから構成され る。クライストロンカソード電圧の安定度はクライスト ロンrf出力の安定度を0.2%以下に保つために0.08%以 下に抑える必要がある。FEL研のrfシステムについ ては、同じ研究会で森井らによって詳細な報告があるの で参照されたい[6]。

図4に電子リニアック用のBT系、4台のアンジュレ ータ用のBT系と赤外〜紫外域FEL施設、将来のSR -FELプロジェクト用として0.8GeV蓄積リングの配 列を示した。電子リニアック用BT系は平均して2m毎 に1対の四重極電磁石が配列され、電子入射器からリニ アックの先端まで加速ビームのエミッタンスを大きくし ないようにしながら加速管の軸に沿って輸送できる。



図4 赤外〜紫外域FEL施設と将来のSR-FELプロジェクト用0.8GeV蓄積リングの配列

-23 -

4 台のアンジュレータに対応して4 式のBT系が設計 された。各BT系は、アクロマティックでほぼアイソク ロナスな BT系(22.5°偏向x2)である。運動量幅($\triangle P/P$ $\simeq \triangle E/E$)をもったビームが半径R、偏向角 α の偏向によ ってデバンチ化されるが、その程度 c \triangle t は α ³R $\triangle P/P$ に比例する。22.5°の偏向角は、エネルギー幅0.5%の電 子ビームが 2 つの BT系(22.5°偏向x4)を通過しても \triangle t が0.6ps程度であるということで決められた。

光共振器のアンジュレータ長に対する比は、CLIO, FELIXなどのように2.5前後にする予定であったが、 BT系の偏向角を22.5°としたため、ミラー真空槽のス ペースがとれなくなり、光共振器長を少し長くして比を 3.0にした。アンジュレータ長Lはレーリー長ZRと同じ 程度とする。

4 台の光共振器からのFEL出力は光ガイドを通して 1 階加速器室南壁側に設けた光ガイド用迷路室に導かれ、 それから真上にある3階の4つの利用実験室へ導かれる。 FELの平均出力は電子ビーム出力P・×エネルギー幅 △E/E×1/2を予定しており、それぞれの波長域でのFE Lの応用研究とともに表2に示した。

表2 FEL発振に必要なビームの質とFELの応用

Electron energy	\leq 30MeV	≦75MeV	≦120MeV	≦165MeV
Peak curren				≧100 A
Normalized emitta	$\leq 10 \pi \mathrm{mm} \mathrm{mrad}$			
Energy spread (FW	≦ 0.3 %			
Micropulse duration	≦5 ps			
Micropulse repeti frequency	178.5 MHz			
Macropulse dulati	≦24 μs			
Macropulse repeti frequency	≦10 Hz			
Average beam po	<3.06 kW			
FEL wavelength	20-7 µ m	\geq 1.5 μ m	≧0.54µm	≧0.25µm
FEL average pow	er 3 W	8 W	12 W	5 W
FELapplications	Separation	FEL-CT P	urification Pl	notosynthesis

30MeVBT系と75MeVBT系のアンジュレータUND1, UND2を通過してFELを発生したビームは、それぞれ 次の加速管(AT4+AT5)と(AT6+AT7)に導かれ、再加速さ れるが、スペクトル幅の狭いFEL発生の場合にはビー ムのエネルギー損失 Δ E/Eは1%以下であり、BT系での 偏向によるデバンチも先に述べた程度でビームのバンチ 長~5psと比べて許容できる程度である。再加速された ビームは、次のアンジュレータUD3またはUD4で再びF ELを発生し、さらにまた偏向されて蓄積リングへの入 射や陽電子の発生に使用される。 FEL研BT系のラテイス設計は、同じ研究会で宮内 らによる詳細な報告があるので参照されたい[7]。表2 はFEL発振に必要なビームの質とFEL研で予定して いるFEL応用の例を示す。

4. 謝辞

電子入射器、加速管系については三菱電機(株)の鈴 木敏允氏、西原進氏、クライストロンE3729と1AV88R については(株)東芝の米澤宏氏、長パルス・クライス トロン変調器については日新電機(株)の宮井裕三氏、 大下英次氏、伊藤勲氏、駆動用rf源については(株) ダイヘンの三宅修治氏と日本高周波(株)の松本博文氏、 SHB電源についてはパルス電子技術(株)の油浦守正 氏の協力を得ました。ここに感謝の意を表します。

5. 参考文献

- T. Tomimasu, et al., Proc. HEACC'92 (Hamburg, July 20-24, 1992) p.1133
- [2] R. Chaput, Proc. EPAC'90 (Nice, France) p.544
- [3] R. J. Bakker, et al., Nucl. Instr. Meth. A307, 543 (1991)
- [4] J. D. Lawson, In Advances in Electronics and Electron Physics 13C, ed. A. Spetier (Academic Press, New York, 1983)
- [5] T. Tomimasu, IEEE Trans. Nucl. Sci. NS-28(3), 3523 (1981)
- [6] 森井他, "The RF System of FELI" in this proceedings
- [7] 宮内他, "Lattice Design of the BT System of FELI" in this proceedings